### Construção de Memórias Yuri Kaszubowski Lopes

UDESC

### **RAM**

- Memória de Acesso Aleatório Random Access Memory (RAM)

  - Permite o acesso direto de qualquer palavra na memória
     Diferente de uma fita por exemplo, onde para acessar a palavra n, precisamos percorrer todas as n-1 posições



Anotações

Anotações

### **RAM**

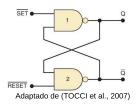
- Comumente chamamos a memória principal de nossos PCs de memória RAM
  - Não é o termo ideal, já que a vasta maioria das memórias que usamos em nossos computadores é do tipo RAM



Anotações			

### Static RAM (SRAM)

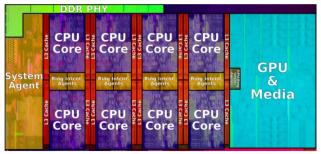
- Memória Estática de Acesso Aleatório (SRAM)
- Utiliza portas lógicas para armazenar os bits
  - ► Flip-flops
- Consegue manter os dados enquanto o circuito está alimentado



# Anotações

### Static RAM (SRAM)

• Comumente utilizada na construção de memórias cache e registradores



Intel Core i9-9900K 16 MiB de Cache L3

Anotações			

### Dynamic RAM (DRAM)

- Memória Dinâmica de Acesso Aleatório (DRAM)
- Armazena carga em capacitores
- Capacitor pode ser interpretador como:
  - ▶ 1 quando carregado
  - 0 quando descarregado
- Mantém os dados enquanto alimentada
- Porém:
  - ► Capacitores perdem a carga com o tempo, e são necessárias recargas (refresh) periódicas (e.g., a cada 64 ms)

  - Ler um capacitor remove sua carga
     Perdemos o dado se não regravar após uma leitura

Anotações			

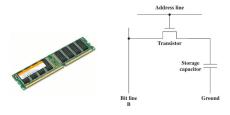
### Dynamic RAM (DRAM)

A memória é denominada dinâmica por sua tendência em perder a carga em seus capacitores

Anotações

Anotações

- Mesmo com a memória continuamente energizada
- DRAM é comumente utilizada na memória principal dos PCs



### **SRAM Versus DRAM**

- SRAM comumente é mais rápida que DRAM
- DRAM possui um circuito mais simples e menor
  - Memórias mais densas e baratas

(KL (UDESC)	Construção de Memórias	

### Read-Only Memory (ROM)

- Memória Somente Leitura (ROM)
  - Podemos ler, mas não escrever
     Memória não volátil
  - - Não precisa estar constantemente alimentada
- A memória é construída com o dado de forma "hardwired"
  - ► Elevado custo de fabricação inicial, independente de quantas memórias
    - vamos construir

      \* Precisamos programar as máquinas e criar máscaras para fabricar as memórias

      \* Não há espaço para erro

Ak 2		
Anotações		

### Programmable ROM (PROM)

- ROM Programável
- O mesmo que uma ROM, mas pode ser gravada uma vez
- Comumente usamos equipamentos específicos que "queimam" os circuitos internos da memória para efetuar a gravação

YKL (UDESC)

Construção do Momórios

10/28

Anotações

### Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM)

- PROM "apagável"
- Pode ser lida ou escrita, mas antes de uma escrita precisa ser completamente apagada
- Usamos radiação ultravioleta em uma janela por alguns minutos



YKL (UDESC

Construção de Memórias

11/28

## Anotações

### Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM)

- PROM "apagável por eletricidade"
- Podemos ler e escrever qualquer palavra individual
- Escrita demora mais tempo que a leitura

Anotações		

YKL (UDES

Construção de Memórias

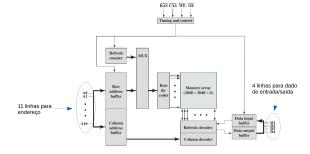
12/28

### Exemplo de arranjo

- Considere uma DRAM de

  - 16 Mib (2 MiB)
     A leitura/escrita é feita em conjuntos de 4 bits
- As memórias DRAM (e ROM, EPROM, ...) são comumente arranjadas
- No exemplo podemos ter uma matriz de 2048 x 2048, onde cada elemento armazena 4 bits
  - Outros arranjos também são possíveis
- Quantos bits são necessários para endereçar uma linha dessa matriz? E para as colunas?
   11 bits, pois 2<sup>11</sup> = 2048, ou melhor: lg 2048 = 11

### Exemplo de arranjo

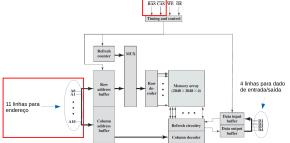


• Temos 11 linhas para o endereço, e não 22, como?

### Anotações

Anotações

### Exemplo de arranjo

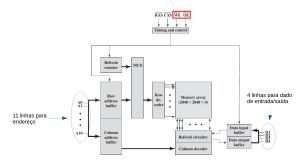


- Enviar
  - ► Di

Refresh Commer  An  An  An  An  An  An  An  An  An  A	
o endereço da linha, depois da coluna	
uas etapas: salvamos pinos de endereço dicar se estamos passando o endereço de linha ou coluna:	
<ul> <li>★ RAS: Row Address Select</li> <li>★ CAS Column Address Select</li> </ul>	

Anotações

### Exemplo de arranjo



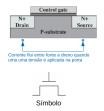
 $\bullet$  Write Enable  $(\overline{WE})$ e Output Enable  $(\overline{OE})$  indicam se os dados são para leitura ou escrita no endereço especificado

YKL (UDESC)	Construção de Memórias	16/28

### Anotações

### Transistores e Células de Memória Flash

Transistor convencional



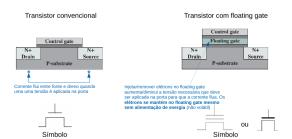
YKL (UDESC)

Construção de Memórias

17/28

# Anotações

### Transistores e Células de Memória Flash



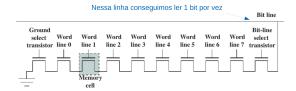
### Memórias Flash

- O microchip é construído de forma que uma seção de memória é rapidamente apagada em um único "flash"
- Um dos arranjos mais comuns é o NAND flash

  - Comportamento similar a portas NAND
     Outras configurações, como NOR flash são possíveis
- Utiliza transistores com floating gate
  Tipicamente são utilizados 32 ou 64 transistores em série
  - \* Armazenar 32 ou 64 bits
  - Os transistores em uma mesma linha não podem ser lidos em paralelo
     Para apagar os transistores, a linha inteira (com 32 ou 64) é apagada

YKL (UDESC)	Construção de Memórias	19/

### Flash NAND



• Exemplo de arranjo com 8 transistores

### Flash NAND



• O Bit line lê 0 lógico quando todos os transistores possibilitam a passagem de corrente. Comportamento de uma porta NAND

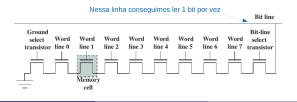
Anotações		
Anotações		

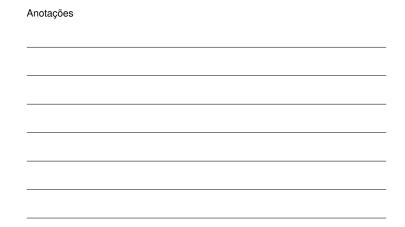
Anotações

### Flash NAND

- Para ler o bit na Word line 1:
  - ► Mantemos as (outras) Word lines 0,2,3,...7 com uma tensão positiva, para que a corrente possa fluir

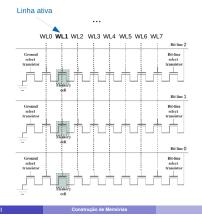
    Mantemos a word line 1 com 0 volts
  - - Agora a corrente vai fluir ou n\u00e4o dependendo do estado do floating gate da Word line 1
  - Como todos os transistores permitem a passagem de corrente, exceto o 1 que depende do estado do floating gate, a linha de bit vai ter 0 ou 1 dependendo do estado da Word line 1





### Flash NAND

• Múltiplas linhas são unidas para formar as words



notações			

### Flash NAND

- A explicação sobre a Flash NAND é apenas uma simplificação sobre o funcionamento real da memória flash
- Operações para apagar e escrever são um pouco mais complexas
- O floating gate se desgasta com o tempo
  - ► Com nossa tecnologia atual, as memórias flash comumente têm uma durabilidade limitada

Anotações			
			_
			_

### Memória Flash

- Memórias flash são comumente utilizadas na construção de pendrives (flashdrives) e Dispositivos de Estado Sólido (Solid-State Drive – SSD)
- Em ambos dispositivos o arranjo NAND é o mais comum





Anotações

YKL (UDESC)	Construção de Memórias	25/28

Exerc	ícios

- Nossos PCs usam uma combinação de SRAM, DRAM e Discos Rígidos SSDs como memórias. Microcontroladores utilizam outra combinação. Pesquise sobre os microcontroladores PIC (fabricados pela Microchip) e verifique quais tecnologias de memória são utilizadas para armazenar o programa, memória principal e armazenamento permanente. Quais vantagens e desvantagens?
- Quais das memórias discutidas são RAM? Quais não são?
- Pesquise sobre o funcionamento básico de Discos Rígidos (HDs) convencionais

(KL (UDESC)	Construção de Memórias	26

### Referências

- Stallings, W. Arquitetura e organização de computadores. 10a ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
- Micheloni, R.; Crippa, L.; Marelli, A. Inside NAND Flash Memories. 2010.
- Tanenbaum, A. Bos, H. Sistemas Operacionais Modernos. 4a ed. 2016
- Novotný, R.; Kadlec, J.; Kuchta, R. Nand flash memory organization and operations. Journal of Information Technology & Software Engineering. 2015.
- Ronald Tocci, Neal Widmer, Greg Moss. Digital Systems. 12 ed. Pearson Education. 2016.

Anotações	
Anotações	
- Indiagous	